

Дата публикации объявления 15.10.2021 г.
Адрес объявления на сайте ВАК <https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100060453>

Информация о соискателе

Тип диссертации Кандидатская
Фамилия, имя, отчество соискателя Шубина Ксения Юрьевна
Наименование темы диссертации Формирование и исследование свойств эпитаксиальных структур GaN/Si(111)
Шифр научной специальности 01.04.10 - Физика полупроводников
Отрасль науки физико-математические науки
Шифр диссертационного совета Д 212.238.04
Наименование организации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»
Автореферат [Файл реферата](#)
Интернет-адрес объявления на сайте организации [https://etu.ru/ru/nauchnaya-i-innovacionnaya-deyatelnost/podgotovka-kadrov-vysshey-kvalifikacii/obyavl](https://etu.ru/ru/nauchnaya-i-innovacionnaya-deyatelnost/podgotovka-kadrov-vysshey-kvalifikacii/obyavleniya-o-zashitah-doktorskih-i-kandidatskih-dissertaciy/)
Интернет-адрес текста диссертации на сайте организации https://etu.ru/assets/files/nauka/dissertacii/2021/shubina/dissertaciya_shubina.pdf

Контактная информация

Адрес организации г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 5
Телефон организации (812) 346-44-87
Дата защиты диссертации 16.12.2021
Редакции 1